

## 高性能离线式 PWM 开关电源控制器

#### 概述

FSD12A 为高性能离线式 PWM 开关电源控制器,满足绿色环保标准;电路内置高压启动回路、软启动回路和多重保护功能,具有简化的应用外围和极高的可靠性。在一定的使用条件下,此电路也可作为非隔离应用方案使用。

FSD12A 采用 DIP-8/SOP-8 封装。可广泛适用于各类经济型开关电源中。

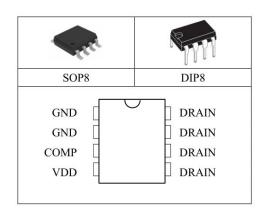
## 主要特点

- ◆ 内置 750V 功率 MOSFET
- ◆ 内置高压启动回路
- ◆ 输入电压 (85V~265V) 全电压范围
- ◆ 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
- ◆ 软启动功能
- ◆ 内置过载、过温、VDD 过压、输出开/短路保护 功能
- ◆ 具有频率调制和抖频功能,具有较好的电磁干 扰 (EMI) 兼容性
- ◆ 空载功耗小于 0.15W,220VAC 输入时小于0.1W

#### 典型应用

- ◆ 小家电电源
- ◆ 电磁炉电源
- ◆ 适用于全电压范围内 6W 使用

## 引脚排列



## 引脚功能

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述	
1	GND	接地端	5			
2	GND	接地端	6	DD A INI	输出脚,接开关变压器	
3	COMP	反馈输入端	7	DRAIN		
4	VDD	电源端	8			



## 电路功能框图

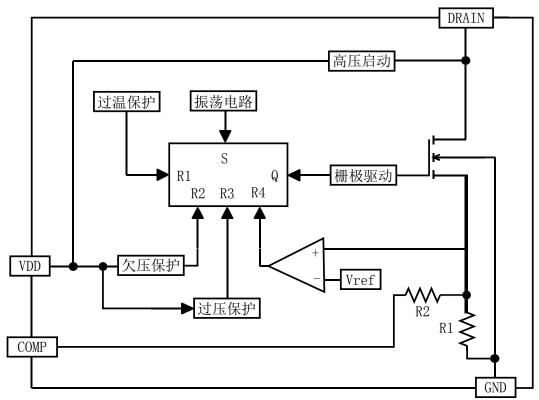


图1. 电路功能框图

#### 最大额定值

项目	符号	范围		单位	
电源电压	$V_{ m DD}$	-0.3~45		V	
反馈耐压	COMP	-0.3~6		V	
DRAIN 端电压	$\mathrm{D}_{\mathrm{rain}}$	-0.3~750		V	
	$\theta_{\mathrm{JA}}$	SOP	105	°C/W	
PN 结到环境的热阻		DIP	85	°C/W	
工作结温范围	TJ	-40 ~ +150		°C	
储存温度范围	$T_{STG}$	-55 ~+150		°C	
ESD (人体模型)		2		KV	

#### 注意:

- (1)如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件下,其稳定性可能会受到影响。
  - (2) 无特殊说明, 所有的电压以 GND 作为参考。



# 电气参数(无特别说明情况下,TA=25℃)

符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
VDD 电压部分							
$V_{ m DD}$	工作电源范围	_	10	_	35	V	
$ m V_{DD\_ON}$	VDD 启动阈值电压	_	13	15	17	V	
$V_{ m DD\_OFF}$	VDD 欠压保护阈值电 压	_	7	8	9	V	
$V_{DD\_RST}$	VDD 供电重启电压	_	-	6.0	-	V	
$V_{ m DD\_OVP}$	VDD 过压保护电压	_	36	40	44	V	
$I_{HV}$	VDD 启动充电电流	V <sub>AC</sub> =85V~265V	-	1.25	-	mA	
I <sub>START</sub>	启动工作电流	$V_{\rm DD} = V_{\rm DD\_ON}$ -1V	-	300	-	μΑ	
I <sub>DD</sub>	工作电流	$V_{DD} = V_{DD\_ON} + 1V$ $V_{COMP} = 0.5V$	-	3.5	6	mA	
振荡器部分							
OSC	振荡频率	$T_{\mathrm{J}}$	38	43	48	kHz	
FD	抖频			±5		kHz	
电流检测部分	<del>}</del>						
$I_S$	输出限制电流	$T_{\mathrm{J}}$	500	600	700	mA	
COMP 检测	部分						
$V_{COMP\_SP}$	COMP 关闭阈值电压	_	1.1	1.2	1.3	V	
$R_{COMP}$	COMP 输入阻抗	_	-	1.0	-	kΩ	
脉宽调制部分	<del>}</del>						
D <sub>MAX</sub>	最大占空比	_	-	-	90	%	
$\mathrm{D}_{\mathrm{MIN}}$	最小占空比	_	5	_	-	%	
$T_{LEB}$	前沿消隐时间	_	-	400	-	nS	
Tonmin	最小开通时间	_	-	800	-	nS	
温度保护检测	测部分						
$T_{SD}$	热保护温度	_	-	160	-	$^{\circ}$	
T <sub>SD_DLY</sub>	热保护滞回温度	_	-	30	-	$^{\circ}$	
功率 MOSF	ET 部分						
$ m V_{BVDSS}$	MOSFET 漏源耐压	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =0.25mA	750	-	-	V	
R <sub>dson</sub>	MOSFET 导通电阻	$I_D=1A$	-	17	-	Ω	

## 典型应用线

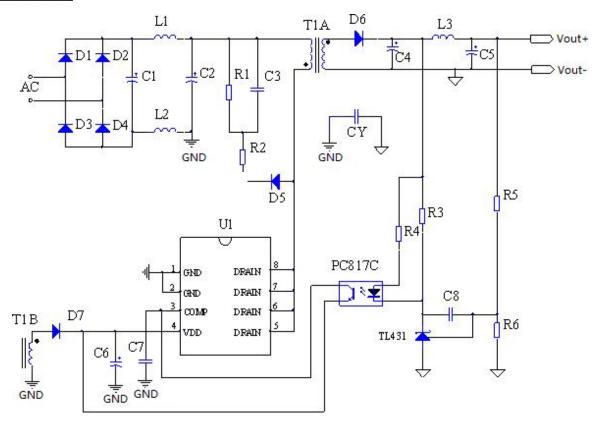
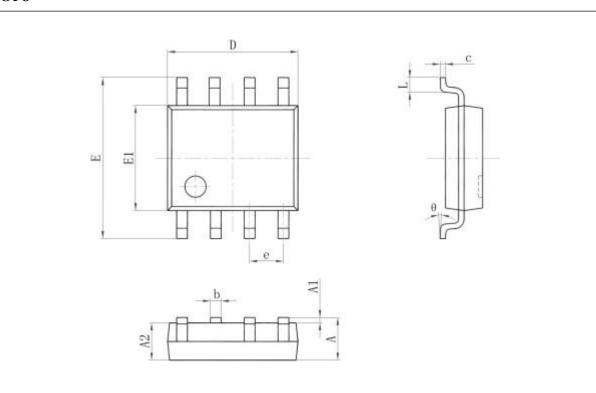


图 2. 典型应用图



# 封装外形及尺寸图

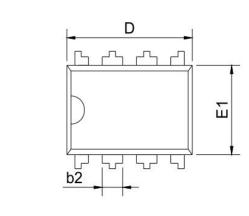
#### SOP8

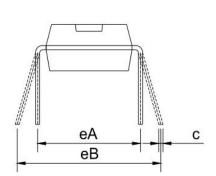


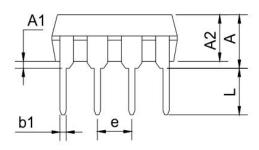
	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
A	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	
c	0.170	0.250	0.006	0.010	
D	4.700	5.100	0.185	0.200	
E1	3.700	4.100	0.150	0.157	
Е	5.800	6.200	0.228	0.224	
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)		
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	0°	8°	



### DIP8







Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions	Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max		
Α	3.600	4.000	0.142	0.157		
A1	0.380		0.015			
A2	3.000	3.600	0.118	0.142		
b1	0.390	0.530	0.015	0.021		
b2	1.52BSC		0.060BSC			
С	0.200	0.350	0.008	0.014		
D	9.050	9.450	0.356	0.372		
E1	6.200	6.600	0.244	0.260		
е	2.54BSC		0.100BSC			
eA	7.320	7.920	0.288	0.312		
еВ	8.000	9.000	0.315	0.354		
L	3.000		0.118			